大気チェレンコフ望遠鏡用 高速サンプリングASIC アナログメモリーセルの開発

遠山 健、大石 理子、大和田英樹^A、窪秀利^B、
田中真伸^A、吉越 貴紀
東大宇宙線研、A:高工研、B:京大理
2010年物理学会@北九州

目次

- **Analog Memory Cellの役割と動作**
 - 解像型大気チェレンコフ望遠鏡の観測システム
 - アナログメモリーの動作
- **開発のメリット**
- **Analog Memory Cellの設計**
 - スイッチングスピード・精度
- **今後の予定**

解像型大気チェレンコフ望遠鏡の観測システム

～ガンマ線検出までの流れ～

γ 線が大気に侵入

空気シャワー現象

チェレンコフ光を発光

鏡で集光

光電子増倍管で検出

光電子増倍管からのアナログ信号をデジタル信号に変換する

チェレンコフ光の光量を
精度よく検出する必要がある

Analog Memory Cellの動作

- あとでゆっくり各capacitorの電圧値をAD変換 (MAX50MHz予定)

Analog Memory Cellの利点

0.5umプロセス

- 低消費電力 : 70mW/ch (FADC:数W/ch)
- コンパクト (4mm × 4mm)
- 安い (大量生産時)

望遠鏡のアレイ化に貢献

- 夜光の影響を抑えることができる

積分時間がパルス幅と比べ長い
夜光の影響が大きくなり、S/N比が低下

波形サンプルで積分時間を最適化
夜光の影響を低減
チャンネルごとの時間差も計測
(同一イベントにおける)

Analog Memory Cellの設計

目標仕様

電圧値精度 :12bits

-浮遊容量による影響、熱ノイズ、過渡現象

サンプリングスピード :1GHz

-1n秒のdelay (CMOSインバーターで実現)

アナログ帯域 :500MHz

※紫は前回とりあげた内容

- ・KEK共同のASIC開発
- ・0.25umのプロセス(台湾のUMC社で製造)
- ・hspiceSシミュレーションにより設計
- ・今回の試作を元に最終版を作成

今回はスイッチの浮遊容量による影響・改善

Delay回路

全体シミュレーションについて取り上げる

スイッチの浮遊容量による影響が出る場所

この部分について説明

浮遊容量による影響

入力 MAX1V

スイッチ

浮遊容量による影響

浮遊容量による影響

浮遊容量による影響

浮遊容量による影響

浮遊容量による影響

浮遊容量による影響

読出しスイッチの改善

読出しスイッチの構成

前回	今回
NMOSスイッチ	NMOSスイッチ
	CMOSスイッチ

性能を比較

Delay回路

この部分について説明

Delay回路

Delay回路

Delay回路

Delay回路

Delay回路

電流源で電圧変化を制御

Delay回路

シミュレーション結果

全体シミュレーションによる動作確認

Input

- 入力信号
100MHz
- スイッチの
制御信号

output

- アンプの出力

サンプリング・読出し
動作確認ができた

今後の予定

- レイアウトを9/13に提出
- 評価用のボードを制作
- 性能評価試験
- 最終版を設計